

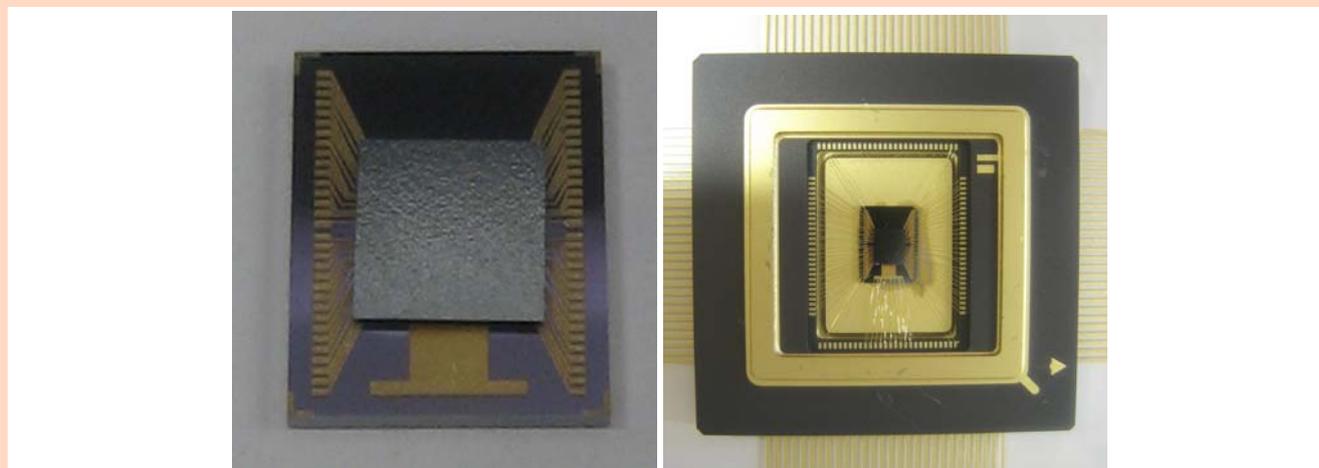
64-элементная (8×8) фотодиодная матрица

PD21BS 8×8

Длина волны в максимуме чувствительности	λ_{\max}	мкм	2.0÷2.1	@22 °C
Токовая чувствительность	S_i	А/Вт	≥1	
Темновое сопротивление (среднее значение по чипу)	R_0	кОм	20	
Обнаружительная способность	$D^*_{\lambda_{\max}}$	смГц ^{1/2} Вт ⁻¹	≈2×10 ¹⁰	
Быстродействие	τ	нс	≤20	¹

Обозначение изделия/ Обозначение корпуса	Чувствительная область, мм ² / Размер чипа, мм	Вес изделия, грамм	Дополнительные оптические компоненты	Угол зрения, градус	Количество бракованных элементов, шт	Температурный диапазон эксплуатации, °C
PD21BS 8M/ 4233.112-A	64×(0.25×0.25) / 2.2×2.5	≤15	Крышка с сапфировым окном (опция)	~160	≤4	-60÷+80

Внешний вид изделия



Описание

- Фоточувствительный элемент на основе гетероструктуры, выращенной на подложке n⁺-GaSb;
- Ввод излучения через свободную от контактов поверхность (флип-чип конструкция);
- Индивидуальная адресация элементов. Общий минус;
- Возможность монтажа на термоэлектрическом охладителе

Преимущества

- Не требует охлаждения;
- Работа без внешнего смещения;
- Одновременное детектирование быстропротекающих и непрерывных процессов;
- Отсутствие деградации полупроводниковой структуры

Примечания

1 – согласно оценкам

27.01.15

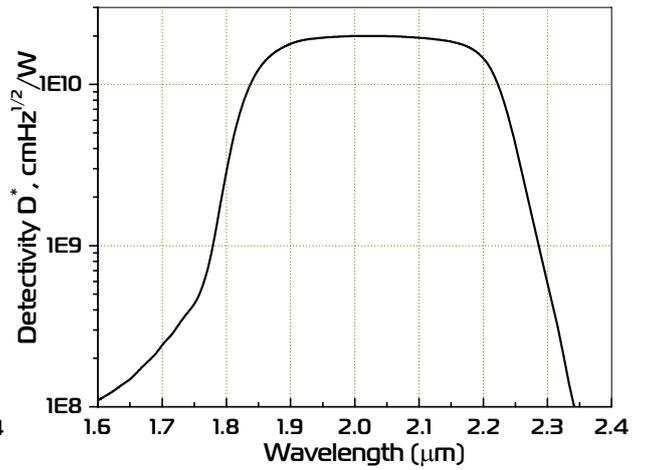
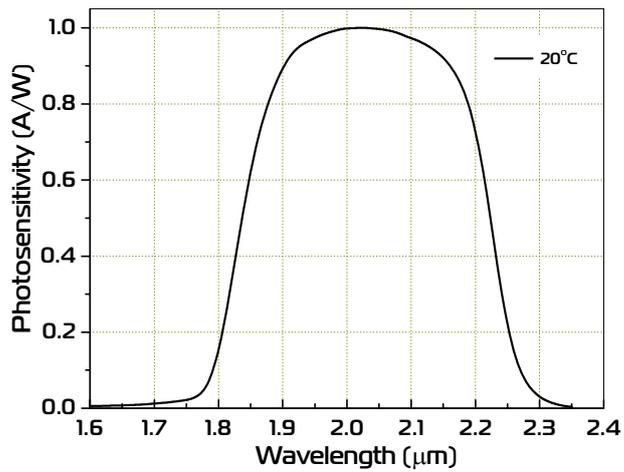


ООО «ИоффеЛЕД»
ioffeLED, Ltd

Politechnicheskaya 26,
St.Petersburg, 194021, RUSSIA

<http://www.ioffeled.com>; e-mail: Mremenny@mail.ioffe.ru
<http://www.mirdog.spb.ru>; e-mail: bmat@iropt3.ioffe.ru

Спектры фоточувствительности



Примечания

Характер температурных изменений параметров фоточувствительности аналогичен приведенным для иммерсионных фотодиодов PD21

